

Номер реєстрації, який є номером свідоцтва	8
Дата реєстрації	25.10.2007
Номер заявки	t 2007 00003
Дата подання заявки	12.06.2007
Дата першого використання топографії ІМС	06.08.2004
Дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом	25.10.2007
Дата публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС та номер бюлетеня	25.10.2007, Бюл. № 17
Заявник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал"
Автор(и)	Ткаченко Володимир Олександрович, UA, Філь Віталій Ілларіонович, UA, Сапон Сергій Васильович, UA, Шельпук Георгій Данилович, UA
Власник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал", Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103
Назва топографії ІМС	5А СТАБІЛІЗАТОР ПОЗИТИВНОЇ НАПРУГИ З НИЗЬКОЮ ЗАЛИШКОВОЮ НАПРУГОЮ KD1084-Cr (LM1084, IL1084)
Ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи	Вдовенко Надія Василівна
Адреса для листування	ТОВ "НВО "Кристал", п/с 22, м. Київ, 04078

Реферат:

Назва ІМС-5А стабілізатор позитивної напруги з низькою залишковою напругою KD1084-Cr (LM1084, IL1084).

Найменування заявника - Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал".

Галузь застосування - мікросхема застосовується для реалізації блоків живлення різноманітної електронної апаратури.

Призначення - мікросхема має низьку залишкову напругу, що дає можливість підвищити коефіцієнт корисної дії блоків на її основі. Високий вихідний струм мікросхеми дозволяє знизити вагові та габаритні показники апаратури. Мікросхема може використовуватися для реалізації стабілізаторів з фіксованими напругами із ряду: 1,5 В; 1,8 В; 2,5 В; 3,3 В; 3,6 В; 5,0 В, або як стабілізатор з регульованою напругою в діапазоні від 1,25 В до 10 В.

Вид технології - технологія виготовлення ІМС з біполярними транзисторами, іонізованими резисторами, МОН-конденсаторами, з ізоляцією елементів р-п-переходом.

Ознакою топографії є оригінальність конструкції елементів схеми електричної ІМС і оригінальність розташування елементів на кристалі ІМС. Ці нові конструктивні рішення забезпечують необхідні вихідні параметри ІМС при більшій щільності упаковки кристала. Тобто, на одиниці площі кристала розміщується більше елементів схеми, ніж це було раніше. Кінцевим результатом такого підходу є зменшення габаритів кристала. Економічний ефект полягає в збільшенні виходу придатних кристалів з однієї пластинки при незмінних затратах робочого часу, енергоресурсів і витратних матеріалів. Все це приводить до зниження собівартості кристала.

Основні технічні характеристики кристала:

- максимальний вихідний струм - 5 А;
- типове значення залишкової напруги - 1,3 В (при струмі 5А);
- ряд фіксованих вихідних напруг - 1,5 В; 1,8 В; 2,5 В; 3,3 В; 3,6 В; 5,0 В;
- максимальне відхилення вихідної напруги - 1 %.